

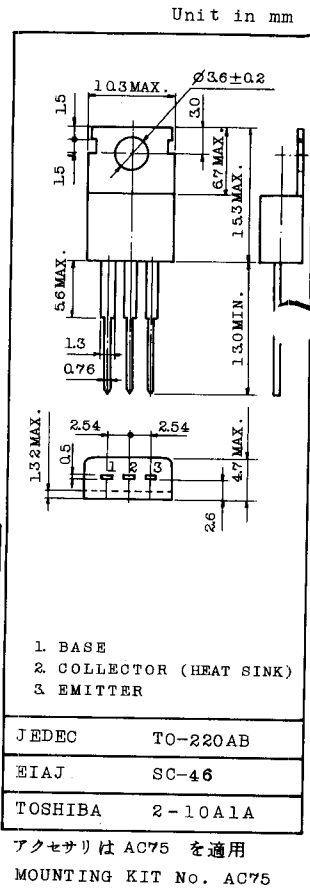
# 2SA816

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 中電力増幅用
- 励振段増幅用
- Medium Power Amplifier Applications
- Driver Stage Amplifier Applications
- 高耐圧です:  $V_{CEO} = -80V$
- 高出力 Hi-Fi Amp の励振段に適します。
- 2SC1626 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1626

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-750	mA
エミッタ電流	$I_E$	750	mA
コレクタ損失	$P_C$	1.5	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$



\* PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -30\text{V}, I_E = 0$	-	-	-0.5	$\mu\text{A}$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	-	-	-1.0	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10\text{mA}, I_B = 0$	80	-	-	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -0.1\text{mA}, I_C = 0$	5	-	-	V
電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	70	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	40	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$	-	-	-0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	-	-	-1.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -150\text{mA}$	50	100	-	MHZ
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$	-	20	-	pF

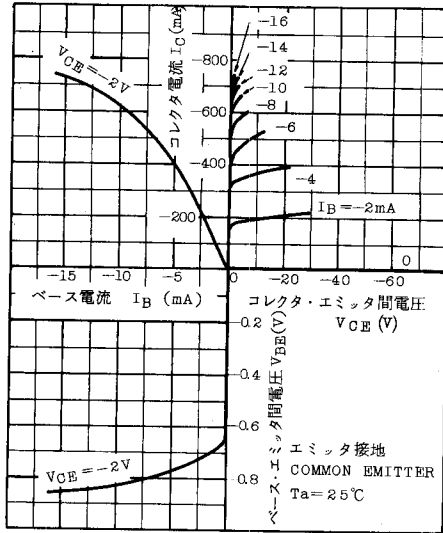
Note :  $h_{FE(1)}$  により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SA816 is classified as follows.

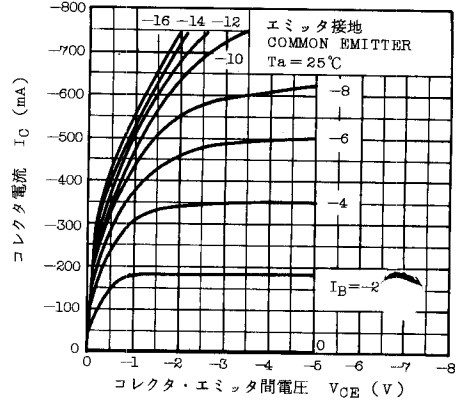
CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SA816-0	70	140
2SA816-Y	120	240

# 2SA816

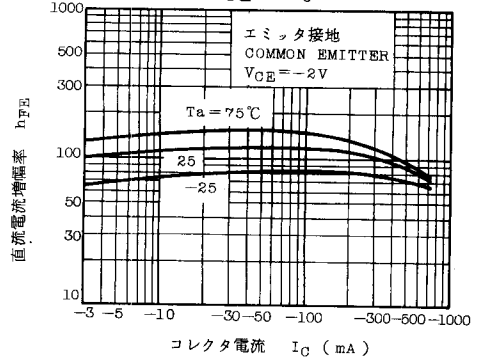
STATIC CHARACTERISTICS



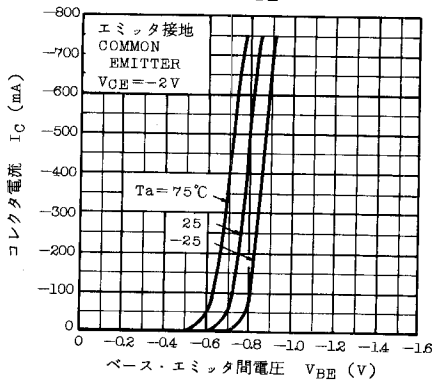
$I_C - V_{CE}$  (LOW VOLTAGE REGION)



$h_{FE} - I_C$



$I_C - V_{BE}$



$V_{CE(sat)} - I_C$

